Intelligent Micro/Nano Sensors

Lotus Deep Reactive Ion Etching

نانوحسگرهای هوشمند لوتوس

تهران- بزرگراه چمران- خیابان باقرخان-
مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)- مرکز
رشد تجهیزات پزشکی

Tel ۰۲۱-۶۶۹۰۲۳۰۸
Email info@imns.ir

فهرست عنوان‌ها

معرفی محصول دستگاه زدایش عمودی عمیق با یون فعال _____ ۲

معرفی محصول _____ ۲

مشخصات فنی محصول _____ ۳

اطلاعات شرکت _____ ۴

معرفی محصول دستگاه زدایش عمودی عمیق با یون فعال

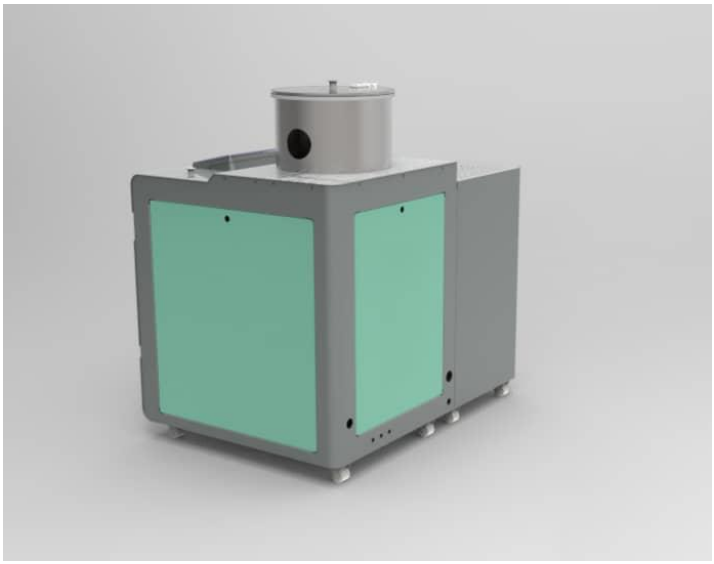
معرفی محصول

در ساخت افزاره‌های نیمه‌هادی داشتن دستگاه‌هایی که قابلیت زدایش ویفر سیلیکونی را داشته باشند از اهمیت بالایی برخوردار است یکی از این تجهیزات دستگاه زدایش عمودی عمیق با یون فعال (Deep Reactive Ion Etching) می‌باشد. این دستگاه توانایی زدایش ناهمسانگرد ویفرهای سیلیکونی را دارد همچنین نرخ زدایش این روش نسبت به روش‌های دیگر بیشتر می‌باشد.

فناوری/محصول ساخته شده و خصوصیات عملکردی شاخص آن

از ویژگی‌های شاخص دستگاه زدایش عمودی عمیق با یون فعال:

- زدایش ویفرهای ۲،۳ و ۴ اینچ
- نرخ زدایش بالا نسبت به دستگاه‌های داخلی
- دارای سیستم پمپینگ توربو
- دارای سیستم ICP
- دارای سیستم خنک کننده بستر
- قابلیت زدایش عمودی عمیق (Vertical Etching)



مشخصات فنی محصول

Plasma Source	Specially Designed Module for High Density Plasma
Sample Size	2", 3", 4" wafers
Source (ICP) Power	RF~ 1000W
Bias Power	RF bias: 13.56 MHz, up to 600 W
High Vacuum Pumping System	TMP + Mechanical Rotary Pump’
Ultimate Pressure	$<5x10^{-5}$Torr within 1 hour

اطلاعات شرکت

نانوحسگرهای هوشمند لوتوس

تهران- بزرگراه چمران- خیابان باقرخان- مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)- مرکز رشد تجهیزات پزشکی

تلفن: ۶۶۹۰۲۳۰۸-۰۲۱

نمابر: info@imns.ir

Intelligent Micro/Nano Sensors